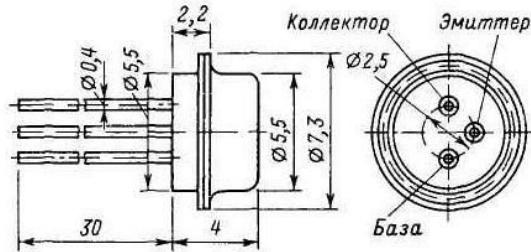


2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В, КТ312А, КТ312Б, КТ312В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в переключающих, усилительных и генераторных схемах радиоэлектронной аппаратуры. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

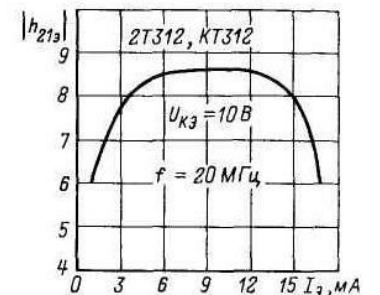
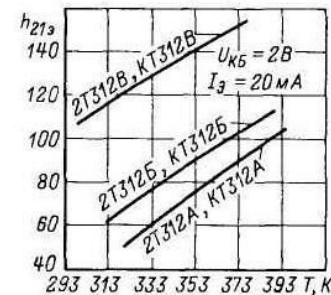
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА не менее	
2Т312А КТ312А	80 МГц
2Т312Б 2Т312В, КТ312Б КТ312В	120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА $f = 2$ МГц не более	
2Т312А КТ312А	500 пс
Время рассасывания при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 2$ мА не более	
2Т312А КТ312А	100 нс
2Т312Б, 2Т312В, КТ312Б, КТ312В	130 нс
Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 2$ В $I_3 = 20$ мА	
2Т312А	12 - 100
КТ312А	10 - 100
2Т312Б, КТ312Б	25 - 100
2Т312В	50 - 250
КТ312В	50 - 280
Граничное напряжение при $I_3 = 7,5$ мА не менее	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	30 В
КТ312А, КТ312В	20 В
КТ312Б	35 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 20$ мА, $I_Б = 2$ мА не более	
2Т312А, 2Т312Б	0,5 В
2Т312В	0,35 В
КТ312А, КТ312Б, КТ312В	0,8 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 20$ мА, $I_Б = 2$ мА не более	
2Т312А, 2Т312Б	1,1 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 2$ МГц не более	
2Т312А, 2Т312Б	5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1$ В, $f = 2$ МГц не более	
2Т312А, 2Т312Б	20 пФ
Обратный ток коллектора не более	
при $T = 298$ К	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В при $U_{КБ} = 30$ В	1 мкА
КТ312А, КТ312В при $U_{КБ} = 20$ В и КТ312Б при $U_{КБ} = 35$ В	10 мкА
при $T = 398$ К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В при $U_{КБ} = 30$ В	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В не более	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	30 В
КТ312А, КТ312В	20 В
КТ312Б	35 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 100$ Ом	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	30 В
КТ312А, КТ312В	20 В
КТ312Б	35 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	4 В
Постоянный ток коллектора	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	30 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	60 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T \leq 298$ К КТ312А, КТ312Б, КТ312В, при $T \leq 333$ К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	225 мВт
при $T = 358$ К КТ312А, КТ312Б, КТ312В	75 мВт
при $T = 398$ К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	62,5 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность при $\tau_{и} \leq 1$ мкс, $Q \geq 10$	
при $T \leq 333$ К	450 мВт
при $T = 398$ К 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	287,5 мВт
Температура перехода	
КТ312А, КТ312Б, КТ312В	388 К
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	423 К
Общее тепловое сопротивление	
КТ312А, КТ312Б, КТ312В	0,4 К/мВт
Температура окружающей среды	
КТ312А, КТ312Б, КТ312В	От 233 до 358 К
2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В	От 213 до 398 К

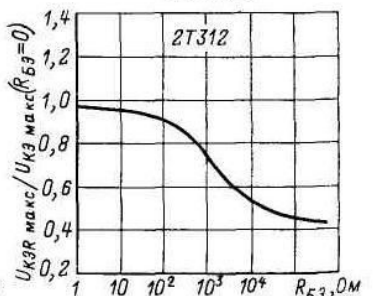
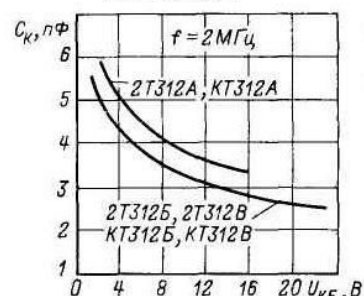
Примечание Изгиб выводов разрешается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5-2 мм

Разрешается производить пайку выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса путем погружения не более чем на 5 с в расплавленный припой с температурой не более 523 К



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры

Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база

Зависимость относительно максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер